

High Purity Red Phosphorus

高純紅磷（高純度赤リン）

Compound semiconductor (substrate, epitaxial layer)

化合物半導体（衬底，外延層）

化合物半導体（基板、エピタキシャル層）

Silicon Wafer (dopant, ion implantation)

硅片（掺杂剂，离子注入）

シリコンウェーハ（ドーパント、イオン注入）



Chunk块状

Size : Max 10mm (1mm-, 2mm-, 5mm-)

Ingot

Dia. : Max ϕ 73mm

Weight : Max 1200g

High Purity Red Phosphorus

Chunk块状



Size :Max 10mm (1mm-,2mm-,5mm-)

Packing: 500g玻璃瓶

分析结果 :

Element		Units	Actual	Specification
Arsenic	(As)	ppm	<0.05	≦0.2
Calcium	(Ca)	ppm	<0.1	<0.1
Chromium	(Cr)	ppm	<0.03	<0.1
Copper	(Cu)	ppm	<0.05	<0.1
Iron	(Fe)	ppm	<0.1	≦0.1
Magnesium	(Mg)	ppm	<0.05	<0.1
Nickel	(Ni)	ppm	<0.1	<0.1
Lead	(Pb)	ppm	<0.08	<0.08
Silicon	(Si)	ppm	<1	<1